

S8550M (3CG8550M)

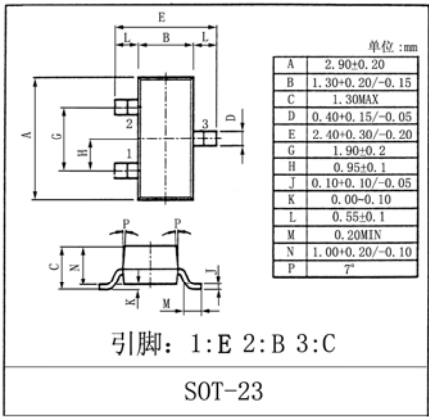
硅 PNP 半导体三极管/SILICON PNP TRANSISTOR

用途:用于功率放大电路。/Purpose: Power amplifier applications.

特点:与 S8050M(3DG8050M) 互补。/Features: Complementary pair with S8050M(3DG8050M).

极限参数/Absolute maximum ratings(Ta=25℃)

| 参数符号<br>Symbol | 数值<br>Rating | 单位<br>Unit |
|----------------|--------------|------------|
| $V_{CB0}$      | -40          | V          |
| $V_{CE0}$      | -25          | V          |
| $V_{EB0}$      | -6.0         | V          |
| $I_C$          | -800         | mA         |
| $I_B$          | -200         | mA         |
| $P_C$          | 450          | mW         |
| $T_j$          | 150          | ℃          |
| $T_{stg}$      | -65~150      | ℃          |



电性能参数/Electrical characteristics(Ta=25℃)

| 参数符号<br>Symbol | 测试条件<br>Test condition           | 数值<br>Rating |            |            | 单位<br>Unit |
|----------------|----------------------------------|--------------|------------|------------|------------|
|                |                                  | 最小值<br>Min   | 典型值<br>Typ | 最大值<br>Max |            |
| $V_{CB0}$      | $I_C=-0.1mA$ $I_E=0$             | -40          |            |            | V          |
| $V_{CE0}$      | $I_C=-2.0mA$ $I_B=0$             | -25          |            |            | V          |
| $V_{EB0}$      | $I_E=-0.1mA$ $I_C=0$             | -6.0         |            |            | V          |
| $I_{CB0}$      | $V_{CB}=-35V$ $I_E=0$            |              |            | -0.1       | μA         |
| $I_{EB0}$      | $V_{EB}=-6.0V$ $I_C=0$           |              |            | -0.1       | μA         |
| $h_{FE(1)}$    | $V_{CE}=-1.0V$ $I_C=-100mA$      | 85           |            | 300        |            |
| $h_{FE(2)}$    | $V_{CE}=-1.0V$ $I_C=-500mA$      | 40           |            |            |            |
| $h_{FE(3)}$    | $V_{CE}=-1.0V$ $I_C=-5.0mA$      | 45           |            |            |            |
| $V_{CE(sat)}$  | $I_C=-500mA$ $I_B=-50mA$         |              | -0.28      | -0.6       | V          |
| $V_{BE(sat)}$  | $I_C=-500mA$ $I_B=-50mA$         |              | -0.98      | -1.2       | V          |
| $V_{BE}$       | $V_{CE}=-1.0V$ $I_C=-10mA$       |              | -0.66      | -1.0       | V          |
| $f_T$          | $V_{CE}=-10V$ $I_C=-50mA$        | 100          | 200        |            | MHz        |
| $C_{ob}$       | $V_{CB}=-10V$ $I_E=0$ $f=1.0MHz$ |              | 15         |            | pF         |

$h_{FE(1)}$  分档、印章/ $h_{FE(1)}$  classifications、Marking:

|                                               |        |         |         |
|-----------------------------------------------|--------|---------|---------|
| $h_{FE(1)}$ 分档<br>$h_{FE(1)}$ Classifications | B      | C       | D       |
| $h_{FE(1)}$ 范围<br>$h_{FE(1)}$ Range           | 85~160 | 120~200 | 160~300 |
| 印章<br>Marking                                 | HY4B   | HY4C    | HY4D    |

